产品规格书



产品型号 : ____SPX0-3225______

标称频率 : ____24.000MHz_____

客户料号:

JWT 料号 : YF4024M00033T8188082

提交时间: 2023-08-10

拟制	审核	批准
五五卷	王新鑫	And T

客户认可:

审核	批准

请将批准后的规格书复印件回传给晶威特电子



合肥晶威特电子有限责任公司

HEFEI JINGWEITE ELECTRONICS CO., LTD

地址:安徽省合肥市经开区云谷路 2569 号

ADD: No. 2569 YunGu Road, HeFei Economy & Technology Development District

FAX: 0551-63350135 mail: hfjwt@hfjwt.cn http://www.hfjwt.cn

修 改 记 录

修改号	页数	修改内容	日期	修改人	审核人
0. 1	1	首次制定	2023. 08. 10	王文荟	王鼎鑫

目 录

序号	内 容	页数
1	产品描述	3~4
2	外形尺寸	5
3	印字	5
4	回流焊曲线(建议)	6
5	产品结构	6
6	编带包装	7~8
7	静电敏感等级	8
8	可靠性	9

● 产品描述

1. 标准状态

除特别规定,在以下标准大气状态下测试:

温度: 25±10℃ 相对湿度: 45%~75%

但对结果有疑义时,测试应在以下范围内:

温度: 25±1℃ 相对湿度: 48%~52%

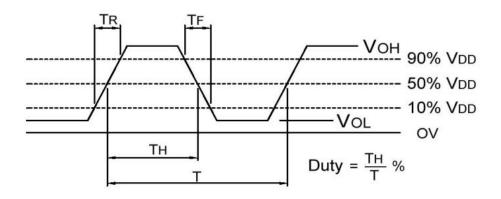
2. 测量仪器

使用 S&A 280B 或者其他相同类型仪器测量电气特性。

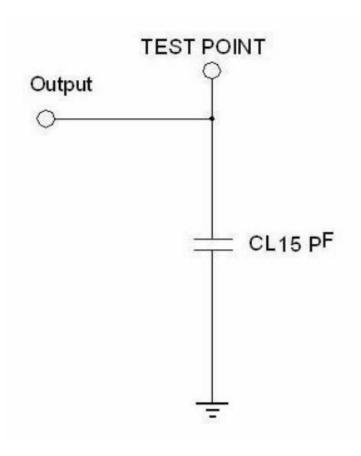
3. 电性能

NO. 参数		符号	规格			备注	
NO.	少 奴	17) 5	最小值	标准值	最大值	单位	田 仁
1	标称频率	F0	24.000		MHz		
2	振荡模式	-		Funda	mental		
3	频率偏差	FT		±10		ppm	
4	老化率	F_age		±3		ppm	First year
5	温度频差	TC		±30		ppm	
6	工作温度	T_use	-40	~	+85	°C	
7	存储温度范围	T_stg	-55	~	+125	°C	
8	供电电压	Vdd	;	3.3±10%		V	
9	电流	Icc			10.0	mA	
10	输出波形	-		CMOS			
11	占空比	TH/T	45	50	55	%	
12	启动时间	Tosc			2	ms	
13	上升时间	Tr			5	ns	10%~90%Vdd Level
14	下降时间	Tf			5	ns	10%~90%Vdd Level
15	高电平	VoH	0.9Vdd			V	
16	低电平	VoL			0.1Vdd	V	
17	输出负载	CL			15	pF	
18	三态	Output Enable	0.7Vdd or Floating			V	Pin 1 Tri-state
		Output Disable			0.3Vdd	V	

4. CMOS 负载输出波形



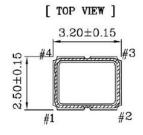
5. CMOS 负载电路测试



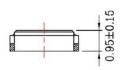
● 外形尺寸

(单位: mm)

A:

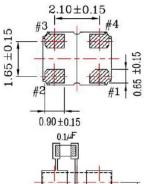


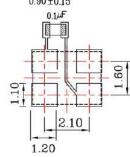
[SIDE VIEW]



☆ To ensure optimal oscillator performance. Place a by-pass capacitor of 0.1. f oscilose to the part as possible between VDD and GND pads.

[BOTTOM VIEW]

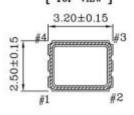




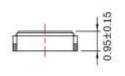
Pin	Function
#1	Tri-State
#2	GND
#3	Output
#4	V_{DD}

B:





[SIDE VIEW]

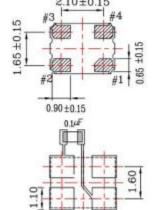


★ To ensure optimal oscillator performance Place a by—pass capacitor of 0.1, F as close to the part as possible between VDD and CND pade.

**TO ensure optimal oscillator performance in the part as possible between VDD and CND pade.

**TO ensure optimal oscillator performance in the part of the part

[BOTTOM VIEW]



1.20

Pin	Function
#1	Tri-State
#2	GND
#3	Output
#4	Vpp

备注:基座外形不同、PIN 脚位标识和形状会有差异,但不影响线路使用。

● 印字



. 24.000

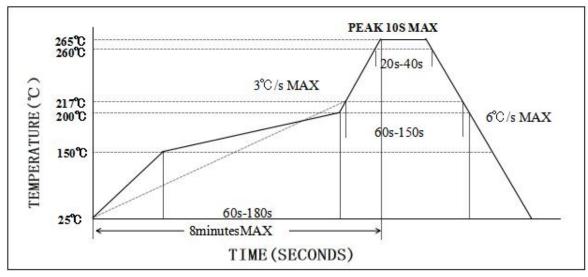
JWT ------ Logo 24.000 ----- 标称频率 • ----- Pin1 **24.000**

• MHZ

24.000 ----- 标称频率

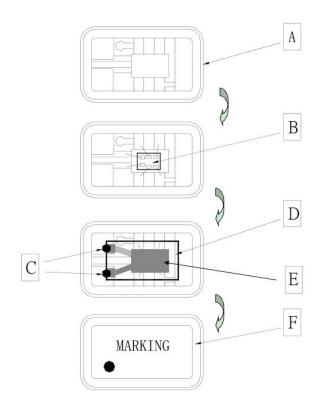
----- Pin1

● 回流焊温度曲线(建议)



参照标准: JEDEC J-STD-020.(无铅)

● 产品结构

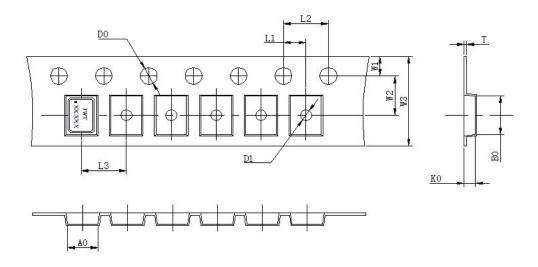


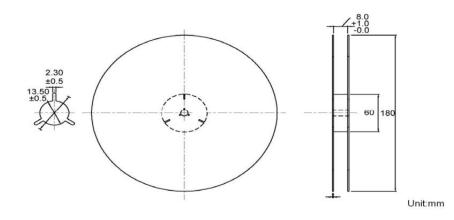
组件及名称		材质	组件及名称		材质
A	基座	$A1_2O_3$	D	晶片	SiO_2
В	芯片	硅	Е	电极	Cr+Ag
С	导电胶	Ag + 硅树脂	F	上盖	Kovar

● 编带包装

(单位: mm)

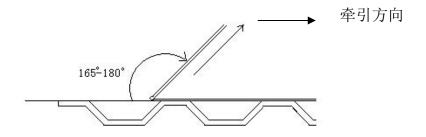
1. 载带与编带盘尺寸



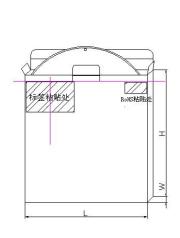


L1	2.00 ± 0.1
L2	4.00 ± 0.1
L3	4.00 ± 0.1
D0	1.55 ± 0.05
D1	1.20 ± 0.5
W1	1.75 ± 0.1
W2	3.50 ± 0.1
W3	8.00 ± 0.2
A0	2.7 ± 0.1
В0	3.4 ± 0.1
K0	1.40 ± 0.1
T	0.25 ± 0.05

2. 剥离方式见下图,强度: 20g-100g



3. 包装方式:



H

1卷/包装盒

10 盒/包装箱

尺寸与数量 (单位: mm)

类 型	尺寸 (L*W*H)	数量
包装盒	180*20*180	3000pcs
包装箱	240*200*200	30000pcs

标准包装: 每卷 3000pcs。

4. 标签内容

- * 客户代码
- * 标称频率
- * 输出负载
- * 频率偏差
- * 供电电压
- * 生产日期
- *订单号
- * 料 号

- * 型号
- * 数量
- * 唛头

★ 备注: 顾客对印字、标签、包装有规定要求的,请提供操作程序。

●静电敏感等级:

HBM: Class3A
MM: ClassC
CDM: ClassIV

●可靠性

1、机械性能试验

序号	测试项目	试验标准	测试方法		判定标准
1	跌落	GB/T2423. 8	晶体从 150 厘米高度自由下落至 3 厘米硬木板, 重复 3 次。		
2	冲击	GB/T2423. 5		半正弦波冲击 (1000G), 持续时间: 0.5ms, X、Y、 Z 三个轴向各 3 次。。	
3	振动	GB/T2423. 10	振动频率 振幅 扫描时间 方向	10~2000Hz 1.52mm 20 min X、Y、Z(三个方向各2小时)	电气性能满足 规格要求
4	可焊性	IEC60068-2-58	焊接温度 浸入深度 浸入时间 助焊剂	245℃±5 ℃ 0.5 mm 3 秒±0.5 秒, 松香树脂甲醇溶剂(1:4)	

2. 环境性能试验

序号	测试项目	试验标准	测试方法	判定标准
5	耐焊接热	IEC60068-2-58	 预热温度 预热时间 60 ~ 120 sec. 焊接温度 浸入时间 10±1 sec. 	
6	高温存储	GB/T2423. 2	晶体在温度+125℃±2℃中放置 500±12 小时。	
7	低温存储	GB/T2423. 1	晶体在温度-40℃±2℃中放置 500±12 小时。	
8	温度循环	GB/T2423. 22	晶体按下表温度做 10 个循环。 1 cycle 1 cycle 25 °C -55+/- 3 °C 30 min. 10 min. max.	电气性能满足规格要求
9	稳态湿热	GB/T2423. 3	晶体在温度 85℃±3℃, 湿度 85%条件下放置 500 小时。	

★ 备注:产品符合公司标准要求,如需测试报告请联系我们。